

Extended InGaAs Photodioden

GAP1000-2.6 TEC2

Wellenlängenbereich

1000nm – 2600nm

Gehäuse

TO-66

Anwendungen

- Prozessüberwachung
- Prozessanalyse
- Infrarot-Spektroskopie
- Optische Leistungsmesser
- Temperaturmessung
- Medizinische Analyse

Eigenschaften

- Hohe Empfindlichkeit
- Hoher Shunt-Widerstand
- Geringe Kapazität
- Planar Design für hohe Zuverlässigkeit

Technische Daten

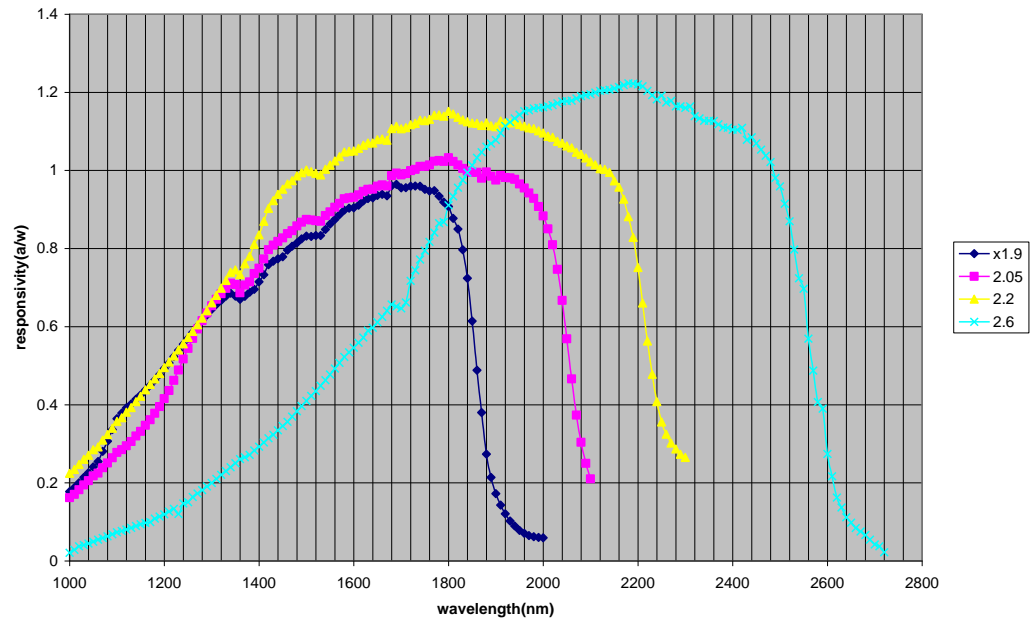
Parameter	Bedingungen @ 23°C ± 2°C	Min	Typ	Max	Einheit
Cutoff Wavelength (50%)		2300	2.4		nm
Peak Responsivity		0.9	1.1		A/W
Shunt-Widerstand	@ 10 mV	2.0	4		KOhm
Dunkelstrom	@ 1.0 V			100	µA
Rauschäquivalente Leistung	@ 2.2 µm		1.5x10 ⁻¹²		W/√Hz
Kapazität	@ 0 V			1000	pF
Bandbreite	50Ω, -3dB, .5V		4		MHz
Rise Time	R _L = 50 Ω		75		ns

Grenzwerte

Parameter	Min	Max	Einheit
Durchbruchspannung		1	V
Arbeitstemperatur	- 40	+ 85	°C
Lagertemperatur	- 40	+ 100	°C



Ext-IGAs PD Spectral Response



Abmessungen

